

# The 65<sup>th</sup> JSAP Spring Meeting 2018

会期 2018年3月17日(土)~20日(火)

会場 早稲田大学西早稲田キャンパス

**登壇申込締切：2018年1月16日(火)17:00(厳守)**  
URL：<https://meeting.jsap.or.jp/entry>

- 分科企画シンポジウム申請締切：2017年11月13日(月)
- 会合(IM)申込締切：2017年1月26日(金)

大会ページ



## ご注意

- 登壇申込締切以後の登録内容の修正、予稿の差し替え、申込の取消はいたしかねます。
- ご提出いただいた予稿の著作権は応用物理学会に帰属します。
- 発表形式(口頭・ポスター)はご希望に添えない場合があります。その際、登壇者の方への事前の連絡はいたしかねますのでご了承下さい。
- 登壇申込締切後のプログラム編集委員会において、複数中分類合同で行うコードシェアセッションの実施を決定することがあります。このため、ご投稿時に希望された中分類ではなく、他の中分類とのコードシェアセッションに講演がプログラムされる場合があります。
- プログラム編集時に、発表を希望した中分類から他の中分類やシンポジウムへ、またはシンポジウムから他の中分類へ移動する場合があります。
- 一般講演における会員1人あたりの登壇件数は口頭講演とポスター講演をあわせて原則3件です。
- 応用物理学(広義の)に関する内容以外を含むもの、応用物理学から著しく逸脱するもの、あるいは本会の品位と信用を損なう恐れがあるものと判断される講演申込は受理しません。

## 一般講演で登壇するための3つのステップ

### 1. 入会登録

※※非会員のみ※※

#### 一般会員

入会金 10,000円

年会費 10,000円

#### 大学生・大学院生

入会金 3,000円

年会費 3,000円

※初年度は年会費無料

### 2. 登壇申込

**1月16日(火)  
17:00締切**

締切以降の取消、差し替え、修正は一切受け付けておりませんのでご注意ください。

### 3. 参加申込

#### 事前予約

正会員・準会員 12,000円

学生 3,000円

シニア会員 4,000円

非会員 23,000円

#### 当日受付

正会員・準会員 18,000円

学生 5,000円

シニア会員 7,000円

非会員 30,000円

以下の常設の大分類、中分類および合同セッション、シンポジウムで一般講演を募集します。講演の日時および講演する分科は1月22日(月)のプログラム編集委員会にて決定し、2月初旬に皆様にお伝えします。

| 大分類分科名 Category  | 中分類分科名                                    | Section  |
|--|---|--|
| 1 応用物理学一般<br>Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology | 1.1 応用物理一般・学際領域                           | Interdisciplinary and General Physics  |
|  | 1.2 教育                                    | Education  |
|  | 1.3 新技術・複合新領域                             | Novel technologies and interdisciplinary engineering   |
|  | 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境                      | Energy conversion, storage, resources and environment  |
|  | 1.5 計測技術・計測標準                             | Instrumentation, measurement and Metrology   |
|  | 1.6 超音波                                   | Ultrasonics  |
| 2 放射線<br>Ionizing Radiation  | 2.1 放射線物理一般・検出器基礎                         | Radiation physics and Detector fundamentals  |
|  | 2.2 検出器開発                                 | Detection systems  |
|  | 2.3 放射線応用・発生装置・新技術                        | Application, radiation generators, new technology  |
| 3 光・フォトニクス<br>Optics and Photonics   | 3.1 光学基礎・光学新領域                            | Basic optics and frontier of optics  |
|  | 3.2 材料・機器光学                               | Equipment optics and materials   |
|  | 3.3 情報フォトニクス・画像工学                         | Information photonics and image engineering  |
|  | 3.4 生体・医用光学                               | Biomedical optics  |
|  | 3.5 レーザー装置・材料                             | Laser system and materials   |
|  | 3.6 超高速・高強度レーザー                           | Ultrashort-pulse and high-intensity lasers   |
|  | 3.7 レーザープロセス                              | Laser processing   |
|  | 3.8 光計測技術・機器                              | Optical measurement, instrumentation, and sensor   |
|  | 3.9 テラヘルツ全般                               | Terahertz technologies   |
|  | 3.10 光量子物理・技術                             | Optical quantum physics and technologies   |
|  | 3.11 フォトニック構造・現象                          | Photonic structures and phenomena  |
|  | 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学                        | Nanoscale optical science and near-field optics  |
|  | 3.13 半導体光デバイス                             | Semiconductor optical devices  |
|  | 3.14 光制御デバイス・光ファイバー                       | Optical control devices and optical fibers   |
|  | 3.15 シリコンフォトニクス                           | Silicon photonics  |
|  | 3.16 Optics and Photonics English Session | Optics and Photonics English Session   |
| 6 薄膜・表面<br>Thin Films and Surfaces   | 6.1 強誘電体薄膜                                | Ferroelectric thin films   |
|  | 6.2 カーボン系薄膜                               | Carbon-based thin films  |
|  | 6.3 酸化物エレクトロニクス                           | Oxide electronics  |
|  | 6.4 薄膜新材料                                 | Thin films and New materials   |
|  | 6.5 表面物理・真空                               | Surface Physics, Vacuum  |
|  | 6.6 プローブ顕微鏡                               | Probe Microscopy   |
| 7 ビーム応用<br>Beam Technology and Nanofabrication                                     | 7.1 X線技術                                  | X-ray technologies   |
|  | 7.2 電子ビーム応用                               | Applications and technologies of electron beams  |
|  | 7.3 微細パターン・微細構造形成技術                       | Micro/Nano patterning and fabrication  |
|  | 7.4 量子ビーム界面構造計測                           | Buried interface sciences with quantum beam  |
|  | 7.5 イオンビーム一般                              | Ion beams  |
|  | 7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術                     | Atomic/molecular beams and beam-related new technologies   |
| 8 プラズマエレクトロニクス<br>Plasma Electronics   | 8.1 プラズマ生成・制御                             | Plasma production and control  |
|  | 8.2 プラズマ診断・計測                             | Plasma measurements and diagnostics  |
|  | 8.3 プラズマ成膜・表面処理                           | Plasma deposition of thin film and surface treatment   |
|  | 8.4 プラズマエッチング                             | Plasma etching   |
|  | 8.5 プラズマナノテクノロジー                          | Plasma nanotechnology  |
|  | 8.6 プラズマライフサイエンス                          | Plasma life sciences   |
|  | 8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野                       | Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications                                      |
|  | 8.8 Plasma Electronics English Session    | Plasma Electronics English Session   |
| 9 応用物性<br>Applied Materials Science  | 9.1 誘電材料・誘電体                              | Dielectrics, ferroelectrics  |
|  | 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子                            | Nanowires and Nanoparticles  |
|  | 9.3 ナノエレクトロニクス                            | Nanoelectronics  |
|  | 9.4 熱電変換                                  | Thermoelectric conversion  |
|  | 9.5 新機能材料・新物性                             | New functional materials and new phenomena   |
| 10 スピントロニクス・マグネティクス<br>Spintronics and Magnetism                                   | 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)                  | Emerging materials in spintronics and magnetism (including fabrication and characterization methodologies) |
|  | 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術                    | Fundamental and exploratory device technologies for spin   |
|  | 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術                | Spin devices, magnetic memories and storages   |
|  | 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関                  | Semiconductor spintronics, superconductor, multiferroics   |
|  | 10.5 磁場応用                                 | Application of magnetic field  |
| 11 超伝導<br>Superconductivity  | 11.1 基礎物性                                 | Fundamental properties   |
|  | 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長             | Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth                            |
|  | 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用                       | Critical Current, Superconducting Power Applications   |
|  | 11.4 アナログ応用および関連技術                        | Analog applications and their related technologies   |
|  | 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用                | Junction and circuit fabrication process, digital applications   |
| 12 有機分子・バイオエレクトロニクス<br>Organic Molecules and Bioelectronics                        | 12.1 作製・構造制御                              | Fabrications and Structure Controls  |
|  | 12.2 評価・基礎物性                              | Characterization and Materials Physics   |
|  | 12.3 機能材料・萌芽的デバイス                         | Functional Materials and Novel Devices   |
|  | 12.4 有機EL・トランジスタ                          | Organic light-emitting devices and organic transistors   |
|  | 12.5 有機太陽電池                               | Organic solar cells  |
|  | 12.6 ナノバイオテクノロジー                          | Nanobiotechnology  |
|  | 12.7 医用工学・バイオチップ                          | Biomedical Engineering and Biochips  |

※12月初旬より開始する登壇申込の際に中分類名や番号が変更になっている場合がございます。

以下の常設の大分類、中分類および合同セッション、シンポジウムで一般講演を募集します。講演の日時および講演する分科は1月22日(月)のプログラム編集委員会にて決定し、2月初旬に皆様にお伝えします。

| 大分類分科名 Category   | 中分類分科名  | Section   |
|---|---|---|
| 13 半導体<br>Semiconductors<br><br>※2018年春より「13.6 Semiconductor English Session」が廃止となったことで、13.6以降の中分類分科名が変更となっております。登壇申込の際は必ず中分類名をご確認ください。 | 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション  | Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials  |
|   | 13.2 探索的材料物性・基礎物性   | Exploratory Materials, Physical Properties, Devices   |
|   | 13.3 絶縁膜技術  | Insulator technology  |
|   | 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術  | Si wafer processing /Si based thin film /Interconnect technology/ MEMS/ Integration technology  |
|   | 13.5 デバイス/集積化技術   | Semiconductor devices and related technologies  |
|   | 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス   | Nanostructures, quantum phenomena, and nano quantum devices   |
|   | 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術  | Compound and power electron devices and process technology  |
|   | 13.8 光物性・発光デバイス   | Optical properties and light-emitting devices   |
|   | 13.9 化合物太陽電池  | Compound solar cells  |
| 15 結晶工学<br>Crystal Engineering  | 15.1 バルク結晶成長  | Bulk crystal growth   |
|   | 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶   | II-VI and related compounds   |
|   | 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎  | III-V-group epitaxial crystals, Fundamentals of epitaxy   |
|   | 15.4 III-V族窒化物結晶  | III-V-group nitride crystals  |
|   | 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶  | Group IV crystals and alloys  |
|   | 15.6 IV族系化合物 (SiC)  | Group IV Compound Semiconductors (SiC)  |
|   | 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥   | Crystal evaluation, impurities and crystal defects  |
| 16 非晶質・微結晶<br>Amorphous and Microcrystalline Materials  | 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス  | Fundamental properties, evaluation, process and devices in disordered materials   |
|   | 16.2 エナジーハーベスティング   | Energy Harvesting   |
|   | 16.3 シリコン系太陽電池  | Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells   |
| 17 ナノカーボン<br>Nanocarbon Technology  | 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料   | Carbon nanotubes & other nanocarbon materials   |
|   | 17.2 グラフェン  | Graphene  |
|   | 17.3 層状物質   | Layered materials   |
| 合同セッションK<br>「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」<br>Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"                          | 薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス, 6.4薄膜新材料, および結晶工学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです。 | This is a joint session of 6.3 Oxide-based electronics, 6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering. |
| 合同セッションM<br>「フォノンエンジニアリング」<br>Joint Session M "Phonon Engineering"  | 9.4熱電変換, 13.7ナノ構造・量子現象, 17ナノカーボンで企画した合同セッションです。                             | This is a joint session of 9.4 Thermoelectric conversion, 13.7 Nano structures and quantum phenomena and 17 Nanocarbon Technology.  |

※シンポジウム一覧は11月下旬に公開いたします。

※12月初旬より開始する登壇申込の際に中分類名や番号が変更になっている場合がございます。

## 参加申込(2018年2月22日(木)締切)

|                                |    |         |    |         |
|--------------------------------|----|---------|----|---------|
| 【正会員・準会員(不課税)】                 | 予約 | 12,000円 | 当日 | 18,000円 |
| 【学生(不課税)】                      | 予約 | 3,000円  | 当日 | 5,000円  |
| 【シニア会員 <sup>(*)</sup> (不課税)】   | 予約 | 4,000円  | 当日 | 7,000円  |
| 【協定学会 <sup>(**)</sup> 会員(不課税)】 | 予約 | 12,000円 | 当日 | 18,000円 |
| 【非会員 <sup>(***)</sup> (税込)】    | 予約 | 23,000円 | 当日 | 30,000円 |

(\*)常勤として勤務に就かれていない60歳以上の会員。一般会員からの種別変更が必要です。

(\*\*)協定学会 : APS(American Physical Society), CSOE(Chinese Society for Optical Engineering), EOS(European Optical Society), EPS(European Physical Society), IOP(Institute of Physics), KPS(Korean Physical Society), OSA(Optical Society of America), OSK(Optical Society of Korea), PESJ(日本物理教育学会), PSROC(The Physical Society of Republic of China), SFP(Soci t  Fran aise de Physique), SPIE(International Society for Optical Engineering), TPS(Taiwan Photonics Society)

(\*\*\*)ご所属先が賛助会員であっても、参加者本人が個人会員でない場合は非会員扱いとなります。